2SB1096/2SD1587

PNP／NPN三重拡散形シリコントランジスタ
カラーテレビ垂直偏向出力用

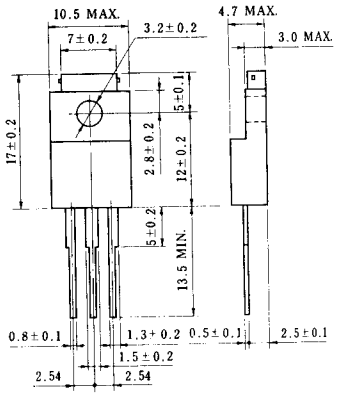
PNP／NPN Silicon Triple Diffused Transistor
Color TV Vertical Deflection Output

特長／FEATURES

○絶縁板および絶縁ブッシングが不要なモールドパッケージです。
○Color TV 14～20" 90°偏向の垂直出力に最適です。
○h_{FE}の直線性，温度特性が良好です。
○異常時の破壊に強い。

外形図／PACKAGE DIMENSIONS

(Unit : mm)



電極接続
① Base
② Collector
③ Emitter

絶対最大定格／ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS (T_a=25 °C)

項目	略号	2SB1096/2SD1587	単位
コレクタ・ベース間電圧	V_{CBO}	−200/200	V
コレクタ・エミッタ間電圧	V_{CEO}	−150/150	V
エミッタ・ベース間電圧	V_{EBO}	−5.0/5.0	V
コレクタ電流（直流）	$I_{C(DC)}$	−2.0/2.0	A
コレクタ電流（パルス）	$I_{C(pulse)}$ *	−3.0/3.0	A
ベース電流（直流）	$I_{B(DC)}$	−1.0/1.0	A
全損失	$P_{T(T_c=25\,°C)}$	25	W
全損失	$P_{T(Ta=25\,°C)}$	2.0	W
ジャンクション温度	T_j	150	°C
保存温度	T_{stg}	−55～+150	°C

＊PW≦10 ms, Duty Cycle≦50 %

電気的特性／ELECTRICAL CHARACTERISTICS (T_a=25 °C)　2SB1096/2SD1587

項目	略号	条件	MIN.	TYP.	MAX.	単位
コレクタしゃ断電流	I_{CBO}	V_{CB}=−150/150 V, I_E=0			-50/50	μA
エミッタしゃ断電流	I_{EBO}	V_{EB}=−4.0/4.0 V, I_C=0			-50/50	μA
直流電流増幅率	h_{FE} **	V_{CE}=−10/10 V, I_C=−0.4/0.4 A	40	90	200	
コレクタ飽和電圧	$V_{CE(sat)}$ **	I_C=−500/500 mA, I_B=−50/50 mA			-1.0/1.0	V
利得帯域幅積	f_T	V_{CE}=−10/10 V, I_C=−0.4/0.4 A		5		MHz

＊＊パルス測定／Pulsed PW≦350 μs, Duty Cycle≦2 %

h_{FE}規格区分

捺印	M	L	K
h_{FE}	40～80	60～120	100～200